Experimental Study of a Si/CdTe Semiconductor **Compton Camera** for the Next Generation of Gamma-ray Astronomy ISAS/JAXA 高橋研究室

東京大学大学院理学系研究科 武田伸一郎

Sub-MeV/MeV 観測

100 keV -- MeV Band はもっとも挑戦的な帯域

粒子加速による非熱的放射が支配的なエネルギー帯域 星の重力崩壊プロセスを知る手懸かりとなる核ガンマ線 銀河中心方向から来るポジトロン由来の 511 keV 線



しかし、最も観測が遅れた帯域 他の帯域に比べて1-2桁感度がわるい 集光鏡によるイメージングできない (cf. X線帯域) 相互作用がコンプトン散乱に支配 (cf. 100 MeV-- GeV 帯域 Fermi) 検出効率が稼げない バックグランドの遮蔽が困難

感度向上の鍵は次世代コンプトンカメラ!

Compton Camera コンプトン運動学を利用した検出器



D₁、D₂ によるコンプトン散乱プロセスの追跡 位置と計測エネルギー (X₁,E₁)と(X₂,E₂)より、

$$E_{in} = E_1 + E_2$$

$$\cos\theta = 1 - m_e c^2 \left(\frac{1}{E_2} - \frac{1}{E_1 + E_2}\right)$$

→イメージング能力

光子の到来方向を円環に制限できる。 位置とエネルギーの正確な測定が鍵

- ・円環を重ね合わせることで線源の場所がわかる。
- ・ 特定の方向からくる光子を抜き出すことができる。

「コンプトン運動学」を用いて、荷電粒子イベント・検出器の放 射化によるバックグランドと天体からの信号とを区別できる



我が国の独自技術に基づいた提案 Takahashi, Makishima and Kamae (2000)

それぞれに特徴あり、実際の検出器の開発と実証が要求されていた (ただし、高度な検出器技術・解析技法が必要)



宇宙観測用次世代コンプトンカメラ

要求されるのは感度の向上のみではない

X線観測との連続性から数 10 keV から数 MeV までカバーする (cf. COMPTEL 750 keV 以上)

△E/E ~ 2% (X線CCD at 6 keV)のエネルギー分解能

角度分解能の理論的な限界まで(ドップラー限界)

偏光観測が出来る (これまで観測そのものがなされていない)

感度がこれまでの検出器を1桁以上上回る

衛星搭載が容易な動作環境

(特に動作温度、読み出し回路、サイズ。。。&コスト)



<u>発表の内容</u>

- ・コンプトンカメラの開発 (第5章)
 半導体検出器の基礎開発より始め、世界で初めて
 Si と CdTe よりなる半導体コンプトンカメラシステムを確立した。
 製作したコンプトンカメラにより、初めて
 天体観測にむけた実証実験が可能となった。
- ・コンプトンカメラの絶対検出効率 (第6章)
- ・コンプトンイメージングの実証 (第7章)
- ・偏光測定能力実証 (第8章)
- ・軌道上性能シミュレーション (第9章)

本講演では省略

Si/CdTe Compton Camera

Si と CdTe の半導体検出器の積層構造



・高い位置分解能による正確な反応位置の測定 (ΔX:数100 um -- mm) ・高いエネルギー分解能による正確な エネルギーデポジットの測定 $\left(\begin{array}{c} \Delta E \sim 1 - 2 \text{ keV for Si} \\ \Delta E/E \sim 1 \% \text{ for CdTe} \end{array}\right)$ 正確なコンプトン散乱プロセスの記録 -> 精度のよい再構成 Si/CdTe の 組み合わせ 効率よくコンプトンイベントを取得 Si (Z = 14) $\sigma_{comp} / \sigma_{photo} > 1$ @ 50 keV CdTe(Z = 48,52)高い光子阻止能 Doppler broadening 影響小さい (3.4 節) -> 高い角度分解能 500 keV 以上の帯域で ~1° (FWHM)



(2) Si と CdTe 検出器を統合、読み出しシステムの構築



10³--10⁴ チャンネルに及ぶ、半導体検出器からの信号を読み出 すシステムを構築し、初めてコンプトンカメラを動作させた。

Si / CdTe コンプトンカメラ (Takeda et al. SPIE 2007)



イメージング実験、偏光測定実験の目的に応じて、検出器構成を カスタマイズ。3種類のコンプトンカメラを製作した。

コンプトンカメラの性能



高いスペクトル性能を達成 8.0 keV (FWHM) @ 511 keV ΔE/E~ 1.5 %

イメージングによるバックグランド 除去能力を実証

・59.5 -- 662 keV の帯域で点線源の イメージングに成功

DSSD の低い検出 Threshold ~5 keV を 達成したことにより初めて実現(世界に例がない)



より詳細な検出器評価

2. 絶対検出効率の評価

絶対検出効率は、検出器の特性として最も重要 a) 天体の絶対フラックスからの物理量の決定 b) 強度分布の正確な測定 など。

絶対検出効率=F(視野(立体角), Dead Time, 較正線源の絶対強度) 特にDead Time補正の「検証」が重要。 数 % の精度で絶対効率を測定できる実験が必須

絶対検出効率の検証

→コンプトンカメラの応答の理解が不可欠

(光電吸収、コンプトン散乱、蛍光X線 etc. with Geometry)

→ Geant4 をベースとしたモンテカルロシミュレーター

実験データとSimulation Output を直接比較し、検証

Dead Timeの「検証」

 Dead Timeを測定
 半減期の短い線源 (¹⁸F, 6.59 x10³ sec) を用意(群馬大学医学部との 共同実験)、半減期を測定、上述のDead Timeが正しいことを検証。



Data Block 2kB/event (Bottom CdTe+DSSD) \rightarrow Count Rate 500 counts/sec,

高精度 MC Simulatorの構築 物理の結果を出すために必須の道具 (Forward Method) Si半導体, CdTe半導体の検出器応答

(半導体内部のキャリア移動等)の組み込みが必要。





DSSD はガウシアンフィット、CdTe は Line Energy ± 5 keV Window 測定値には使用したRI Source の絶対強度の不定性に基づく 10 % のエラー 実験値とSimulator Output は 10 % の程度で一致する。



コンプトン散乱事象を選択、イメージング後、線源を切り出す。 (線源位置より10°以内にコンプトンリングが通った事象を選択)



Si/CdTeコンプトンカメラの絶対検出効率を 10%レベルで求めることに成功。

開発したモンテカルロコードの実証





・300 keV 以上でドップラー限界にせまる角度分解能

2.5° (FWHM) @ 511 keV 角度分解能のエネルギー依存性も Simulator でよく再現

3. コンプトンイメージングの実証

非密封線源を用いた実験 (with 群馬大医学部、原研) 点線源だけでなく、これまでコンプトンカメラでは実証されて こなかった、「拡がった構造のイメージング試験」が可能に

3種類のターゲットを作成。(¹³¹I, 364 keV)



(a) 20 mm ピッチに配列した点線源。径 2 mm

- (b) 直径 20 mm の真円
- (c) 逆 "C" 状。ギャップ 3 mm

(注)以下、Deconvolution Algorithm として、List-Mode Maximum Likelihood
 Expectation Maximization 法を 採用したときの実験結果をしめす。(詳細は7.2節)

Grid 状線源の撮像



- ・配列した点源が正しい位置にイメージングされた。 60 cm 離れた場所で 1 mm 以下の位置決定精度
- ・広い視野にわたるイメージング能力を実証。

拡がった構造の撮像

角度分解能に優れた Si/CdTe コンプトンカメラにより初めて実証



・点線源、真円、逆"C"状、それぞれ真の形状にイメージングされた。

・選択した Deconvolution 法の有用性を確認。

真円が一点に収束すること無く、

逆"C"状のギャップと中心が抜けた構造が正しく Deconvolution された。

・拡がった構造をもつ対象のイメージングを実証した。(Takeda et al. IEEE 2008)

4. 偏光測定能力実証

Semiconductor New !! Compton Camera && Polarimeter

- ・散乱光子の精度のよい追跡 (~mm) により、 精度よく (~1°) 偏光方向を測定できる。 (ただし実証が必要、本発表で)
- ・散乱体を取り囲む構造により、高い 偏光分解能力と検出効率を実現。
- ・イメージングによる低バックグランド観測

(cf. Traditional Compton Polarimeter)



ガンマ線の追跡精度が悪い

SPring-8、BL08Wビームラインで 100 % 偏光シンクロトロン ビームを用いた、偏光測定能力実験を執り行った。



- ・ビームラインからの 250 keV ガンマ線を 90° 散乱させて検出器に入射。
- ・検出器には~170 keV、92.5 % 偏光のガンマ線が入射する。
- ・検出器を回転させて、検出器座標で 0,15,22.5,30,45,90,180°の 偏光ベクトルをもつ 7 種類のデータを取得。
- ・トリガーは CdTe Side 検出器から取得。(DSSD--CdTe Side イベントをつかう。)

Azimuth 散乱分布

検出器座標における Azimuth 散乱分布 ($\phi_{pol} = 0^{\circ}$ のデータ)



・±90°方向と、0,180°方向の計数の違いが入射光子の偏光によるもの。

+ 90°と- 90°方向の~10 %の計数の違いが DSSD 周りの passive material の非一様性によるもの。

Modulation Ratio

シミュレーターで無偏光レスポンス を計算し、検出効率の非対称性を 補正した N_{true} (*φ*)をもとに 以下にRを定義する。

$$R(\phi) = \frac{N_{\text{true}}(\phi) - N_{\text{true}}(\phi + \pi/2)}{N_{\text{true}}(\phi) + N_{\text{true}}(\phi + \pi/2)}$$

R の振幅 (Q) が偏光度に比例し 偏光ベクトルの方向が最小値となる。



偏光度と偏光方向

| | Amplitude | Polarization vector | χ^2/ndf |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| Setup 1 ($\phi_{\rm pol}=0.0$) | 0.82 ± 0.02 | 0.6 ± 0.5 | 66.4/53 = 1.25 |
| Setup 2 ($\phi_{\rm pol}=15.0)$ | 0.82 ± 0.02 | 14.7 ± 0.7 | 56.0/53 = 1.05 |
| Setup 3 ($\phi_{\rm pol}=22.5$) | 0.83 ± 0.02 | 23.4 ± 0.6 | 48.0/53 = 0.90 |
| Setup 4 ($\phi_{\rm pol} = 30.0$) | 0.85 ± 0.02 | 30.0 ± 0.6 | 52.8/53 = 1.00 |
| Setup 5 ($\phi_{\rm pol} = 45.0$) | 0.83 ± 0.03 | 45.0 ± 0.5 | 52.6/53 = 1.00 |
| Setup 6 ($\phi_{\rm pol} = 90.0$) | 0.83 ± 0.02 | 89.3 ± 0.6 | 44.5/53 = 0.84 |
| Setup 7 ($\phi_{\rm pol} = 180.0$) | 0.82 ± 0.02 | 180.1 ± 0.6 | 59.4/53 = 1.12 |

- ・偏光ベクトルの方向は 1°以下の精度で正しく決定された。
- ・R の振幅 (Q) は 0.83 ± 0.02 と求まった。

シミュレーションでもとめた、 92.5 % 偏光に対して期待される Q = 0.84 ± 0.02 高い偏光分解能力を達成 (シミュレーションとも一致)

次世代検出器 本研究により見えてきた次世代検出器



コンプトン運動学を用いた 極低バックグランド観測 1 mCrab (100 ksec) < 300~keV



ガンマレンズとコンプトンカメラ 全天サーベイ & ポインティング

まとめ

Si / CdTe 半導体コンプトンカメラを世界で初めて開発し 天体観測に向けた性能評価をすすめた。

Si と CdTe の詳細な検出器応答のモデル化に成功し高精度の Monte Calro Simulator を構築した。

とくに、従来のコンプトンカメラでは実証されてこなかった 広がった構造のイメージングに成功。

コンプトンカメラが高い精度 (~1°) で偏光方向を決定できる ことを実証した。

100 kg 級コンプトンカメラが到達する感度は、これまでの如何なる検出器よりも1桁上である。

次世代検出器コンプトンカメラに要求される 測定能力を実証した。

